

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成27年2月19日(2015.2.19)

【公開番号】特開2013-16772(P2013-16772A)

【公開日】平成25年1月24日(2013.1.24)

【年通号数】公開・登録公報2013-004

【出願番号】特願2012-956(P2012-956)

【国際特許分類】

H 01 L	27/146	(2006.01)
H 01 L	27/144	(2006.01)
H 01 L	21/336	(2006.01)
H 01 L	29/786	(2006.01)
H 01 L	31/08	(2006.01)
G 01 T	1/20	(2006.01)

【F I】

H 01 L	27/14	C
H 01 L	27/14	K
H 01 L	29/78	6 1 9 B
H 01 L	29/78	6 1 7 T
H 01 L	29/78	6 1 9 A
H 01 L	29/78	6 1 7 N
H 01 L	31/00	A
G 01 T	1/20	E
G 01 T	1/20	G
G 01 T	1/20	L

【手続補正書】

【提出日】平成26年12月15日(2014.12.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0091

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0091】

尚、本変形例では、ゲート電極120B1, 120B2が、本開示における「第1のゲート電極」の一具体例に相当し、ゲート電極120A1, 120A2が、本開示における「第2のゲート電極」の一具体例に相当する。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0111

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0111】

但し、本変形例のトランジスタ111Kは、いわゆるボトムゲート構造を有するものである。上記実施の形態のトランジスタ111Bにおいて、2つのゲート電極のうちのゲート電極120Aのみを備えた構造を有している。このような1つのゲート電極120Aを有するトランジスタ111Kにおいて、上記トランジスタ111Bと同様、ソース・ドレン電極128A, 128Bの一部がシールド電極層128a1, 128b1を兼ねている。このようなボトムゲート構造のトランジスタ111Kにおいても、シールド電極層1

2 8 a 1 , 1 2 8 b 1 によるシールド効果を得ることができる。